EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

60195957

PUBLICATION DATE

04-10-85

APPLICATION DATE

APPLICATION NUMBER

19-03-84

59050939

APPLICANT : HITACHILTD;

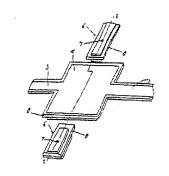
INVENTOR : NAKAZAWA HIROSHI;

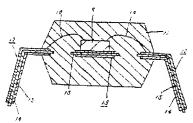
INT.CL.

H01L 23/48 H01L 23/28

TITLE

: LEAD FRAME





ABSTRACT : PURPOSE: To improve the contacting property between a lead frame and a resin and to enhance the sealability and the reliability by stepwisely forming the side of the lead frame, and increasing the contacting surface with the resin.

> CONSTITUTION: Projections 8, 15 are formed on tabs 4, 13 of a lead frame, tab hanging lead 5 and the sides of leads 6, 14. The projection 8 is formed by a suitable method. The lead frame 12 is, for example, composed of 42-alloy. A semiconductor chip 9 is formed, for example, of silicon single crystal substrate, many circuit elements are formed in the chip by the know technique, and one circuit function is formed. A resin sealer 11 is formed, for example, of epoxy resin, and molded by a known transfer molding method.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭60-195957

(5) Int. Cl. 4 H 01 L 23/48 23/28

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)10月4日

7357-5F 7738-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称

リードフレーム

沢

②特 顧 昭59-50939

22日 昭59(1984) 3月19日

勿発 明 者 谷川 ②発 眀 者 中

太 洋 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

勿出 願 人

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

②代 理 弁理士 高橋 明夫 外1名

発明の名称 リードフレーム

特許請求の範囲

- 1. 関面に突出部を設けて成ることを特徴とする リードフレーム。
- 2. 前配リードフレームがプラスチックモールド 用リードフレームである、特許請求の範囲第1項 記載のリードフレーム。

発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明はリードフレームに関し、特に、モール ドレジンとの密着性を良くし、對止性のよい樹脂 掛止型半導体装置を得ることができるリードフレ ームに関する。

〔背景技術〕

リードフレームの構造の一例としては第1図に 示すごときものが周知である(工業調査会刊「IC 化実装技術」P137~P150など)。第1図に て、1は半導体チップをマウントするタブ、2は このタブを吊っているタブ吊りリード、 3 仕半導

体チップの内部配線をコネクタワイヤにより外部 に引出するリードである。このリード側の電極及 び半導体チップ側の電極をコネクタワイヤを用い て、周知の超音波ポンディング法などによりポン ディングして電気的接続を行った後に、樹脂(レ ジン)を周知のトランスファーモールド法なとに より半導体チップやポンディング部上にモールド し、リード3を切断成形するなどして樹脂對止型 の半導体装置を得ることができる。

ところで、かかる樹脂對止型半導体装置にあっ ては、リードフレームとレジンとの密着性を良好 にし、封止性(耐湿性)を向上させ、信頼度を向 上させることが必要であり、近時は半導体チップ の大形化に伴ない、封止巾が増々狭くなっており、 これら事項の重要性も増大している。

従来のこのような樹脂對止型の半導体装置に使 用されるリードフレームにあっては、その側面が フラットに構成されており、リードフレームとレ ジンとの密着性が不足し、封止性、信頼度の向上 という面で問題があることがわかった。

特開昭60-195957(2)

〔発明の目的〕

本発明はリードフレームとレジンとの密暦(接触)面積を増大させて、リートフレームとレジンとの密着性を良好にし、対止性を向上し、信頼度の高い樹脂封止型半導体装置を得ることができるリートフレームを提供することを目的としたものである。

本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な 特徴は、本明細書の記述および派付図面からあき らかになるであろう。

[発明の概要]

本願において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

すなわち、本発明ではリードフレームの側面に 段付けを行い、レジンとの接触面を増大させ、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、リードフレーム表面積増大によるリークパスの伸展 をはかって外部からの湿気等の浸透性異物の侵入 の半導体チップへの到達時間を長くして、封止性 を向上させ、製品寿命を延命し、信頼性を向上さ せることに成功した。

〔 実施例 〕

たに、本発明を実施例に基づき説明する。 第2回は本発明リードフレームの要部斜視図、 第3回は第2回I-I級断面図を示す。

第4図は本発明リードフレームを使用して成る

徴脂封止型半導体装置の断面図を示し、第4図にて、9は半導体チャブ、10はコネクタワイヤ、11は樹脂封止体、12はリードフレームで半導体チャブ9を搭載しているタブ13、及び半導体チャブ9の内部配線をコネクタワイヤ10を用いて外部に引出するリード14にはそれぞれ突出部15が設けられている。

本発明リートフレームは、例えば42アロイ合金により構成される。半導体チップ9は、例えばシリコン単結晶基板より成り、周知の技術によって、このチップ内には多数の回路案子が形成され、1つの回路機能を与えている。回路案子は例えば絶縁ゲート型電界効果トランジスタ(MOSトランジスタ)から成り、これらの回路業子によって、例えば論理回路およびメモリの回路機能が形成されている。コネクタワイヤ10は、例えばアルミニウム(A8)細線により構成される。

樹脂封止体11は、例えばエボキシ樹脂により 構成され、周知のトランスファーモールド法など により形成される。次に、第5図は本発明の他の 実施例を示し、第2図に示すリードフレームのリード6の上面に、さらに、適宜の間隔で横方向に複数の緑条の溝部16を設けて成る実施例を示す。近時、第4図に示すような樹脂財止型半導体装置において、半導体テップ 9 が大形化し、リード14の樹脂財止体11に埋込まれる長さが次第に短はなってきている。そうすると、リード 2 する場合はずま4図に示すような折曲げリードとする場合がで第4図に示すような折曲げリードがかるみ、リードがレジンからスリップし、リードが増助出止体外部によけいに引っぱり出されることになる。かかる溝部16を設けることにより、より一層、リードフレームとレジンとの密着性を向上し得る。

〔效 果〕

- (1) リードフレームの切断面に段付けを行ない、 個面に突出部を形成するようにしたので、その分 リードフレームとレジンとの密層面積が増大し、 リードフレームとレジンの密層性の向上が図られ る。
- (2) 密着面積の増大により、レジン量が増大し、

時開昭60-195957(3)

以上本発明者によってなされた発明を実施例にもとづき具体的に説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、その要旨は途脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。

例えば、前記実施例では、リードフレーム側面 全体に突出部を設けた例を示したが、一部に突出 部を設けても差支之ない。又前記実施例では溝部 をリード上面のみに設けた例を示したが、リード の上下面あるいは下面のみに設けてもよい。 〔利用分野〕

本発明はデュアルインライン(DIL)タイプのバッケージの他、フラットバックタイプのバッケージなど他の樹脂對止型半導体装置にも適用することができ、樹脂對止型半導体装置全般に適用できる。 又電子部品のバッケージ技術にも適用できる。 図面の簡単な説明

第1図はリードフレームの従来例を示す平面図、 第2図は本発明リードフレームの要部斜視図、 第3図は第2図I-I線断面図、

かつ、側面がフラットである場合に比較して、段が形成されているのでリークパスが長くなり、そり結果外部からの半導体装置内部への浸透性異のの侵入が遅くなり封止性(耐湿性)が向上する。(3)リードフレームとレジンとの密着性、封止半さの向上により製品寿命を延命し、樹脂封止型きるいとはできる。(4)半導体チップが大型化し、リードのモーンは、リードフレームとレジンとの密着性の向上の図り、でいる今日、リードフレームに段付の向上の図り、は上性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、おことは工業上極めて有意識である。

(5) リードフレームの個面に突出部を設けることに加えて、第5回に示すように、リードの上面に 溝部を形成することにより、より一層リードフレ ームとレジンとの密着性が向上させることができ、 さらにリード折曲げ成形に際し、リードがゆるん だり、樹脂對止体の外部に突出したりすることを 防止できる。

第4図は本発明リードフレームを使用して成る 樹脂封止型半導体装置の断面図、

第5図は本発明の他の実施例を示すりードフレームの平面図である。

1 …タブ、2 …タブ吊りリード、3 …リード、4 …タブ、5 …タブ吊りリード、6 …リード、7 …樹脂穴、8 …突出部、9 …半導体チップ、10 …コネクタワイヤ、11 …樹脂對止体、12 …リードフレーム、13 …タブ、14 …リード、15 …突出部、16 …棒部。

代理人 弁理士 高 橋 明 夫



